



## طراحی و شبیه سازی افزاره نوری با گذردهی نامتقارن به کمک بلور فوتونی غیر خطی

محسن زارعی محمودآبادی<sup>۱</sup>، محمد کاظم مروج فرشی<sup>۱</sup> و فخرالدین نظری<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - گروه الکترونیک

<sup>۲</sup>دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، دانشکده مهندسی فناوری نوین

**چکیده:** روشی جدید برای طراحی و شبیه سازی یک افزاره نوری با گذردهی نامتقارن بر پایه بلور فوتونی غیرخطی از جنس سیلیکان ارائه می شود. یکی از روش های رایج برای ایجاد گذردهی نامتقارن نوری شکستن تقارن ساختار است. بدین منظور از یک موجبر بلور فوتونی، که در مسیرهای رفت و برگشت با یک کاواک جانبی به طور نامتقارن جفت شده، استفاده می شود. جفت شدگی نامتقارن همراه با اثر غیر خطی که در ساختار امکان ایجاد دو طیف عبور رفت و برگشت با اختلاف ۴۶ db را میسر می سازد. این افزاره با استفاده از یک ساختار بلور فوتونی دو بعدی با شبکه شش ضلعی و ثابت شبکه  $a = 447 \text{ nm}$  متشکل از حفره های هوا به شعاع  $r = 130 \text{ nm}$  در بستر سیلیکان طراحی می شود. قطبش موج ورودی از نوع TE فرض شده است.

**کلید واژه-** بلور فوتونی، اثر غیر خطی، ایزولاتور نوری، طیف عبور، فانو.

### Design And simulation of device with asymmetric Transmission Based on Nonlinear Photonic Crystal

M. Zarei-Mahmodabadi<sup>1</sup>, M. K. Moravvej-Farshi<sup>1</sup>, and F. Nazari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran 1411713116, Iran.

<sup>2</sup>Faculty of Engineering Modern Technologies, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran

**Abstract-** An optical device with asymmetric transmission based on nonlinear silicon photonic crystal is designed. A common approach for producing nonreciprocal (asymmetric) transmission is to break the structural symmetry. For this purpose we utilize a photonic crystal waveguide that is asymmetrically side coupled to a cavity in both forward and backward directions. This asymmetric coupling together with the Kerr nonlinearity can provide the nonreciprocal Transmission Rate of 46db in forward and backward directions. The photonic crystal waveguide is created by a removal a row of air holes from a two-dimensional Si slab photonic crystal with hexagonal lattice of constant  $a=477 \text{ nm}$  and air holes radii of  $r=130 \text{ nm}$ . The polarization of input light is assumed to be TE.

Keywords: Photonic crystal, Kerr nonlinearity, Optical isolator, Transmission, Fano.

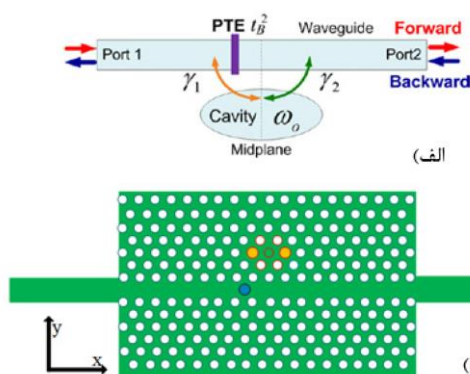
## ۱-مقدمه:

## ۲- ساختار پیشنهادی و نحوه عملکرد آن

شکل ۱ (الف) شمای ساده‌ای از یک افزاره نوری با گذردهی نامتقارن را نمایش می‌دهد. این افزاره شامل یک موجبر، یک عنصر سدکننده و یک کاواک که از پهلو به موجبر کوپل شده است می‌باشد. شکل ۱ (ب) نمای از بالای این ایزولاتور را که در یک تیغه بلور فوتونی به ضخامت  $h = 250 \text{ nm}$  و با ثابت شبکه  $a = 447 \text{ nm}$  و حفره‌های هوا با شعاع  $r = 130 \text{ nm}$  تعبیه شده‌است نمایش می‌دهد. موجبر از یک نقص خطی به پهنای  $w = a$  تشکیل شده‌است. کاواکی که از پهلو به موجبر بلور فوتونی جفت شده با تعبیه یک نقص نقطه‌ای (حذف حفره) و تغییر شعاع دو حفره مجاور آن (زرد رنگ) تشکیل شده‌است. شعاع این دو حفره و کاواک سد کننده برابر  $r_i = 150 \text{ nm}$  است. فاصله کاواک سد کننده از مرکز موجبر به سمت پورت 1 برابر  $l = 670 \text{ nm}$  است.

اساس عملکرد ساختار استفاده از یک کاواک برای بالا بردن فعل و انفعالات بین نور و ماده غیرخطی به علاوه شکستن تقارن فضایی ساختار و همچنین تولید رزونانس فانو برای دستیابی به ساختار عبوردهنده یکطرفه نور است که از ویژگی‌های این ساختار مصرف توان بسیار پایین و قابلیت تنظیم پذیری طول موج است. همانطور که ذکر شد در ساختار دیود نوری جهت بهبود عملکرد غیر خطی از رزونانس فانو بهره گرفته شده است. رزونانس فانو در سیستم‌های کلاسیکی همانند سیستم‌های مکانیک کوانتومی، از تداخل بین دو مسیر که یک مسیر شامل یک رزونانس گسسته و مسیر دیگر یک مسیر پیوسته است ظاهر می‌شود. همانطور که در شکل (۱) مشاهده می‌کنید برای کنترل

امروزه برای طراحی و ساخت کاواک‌ها و موجبرهای نوری به منظور تشدید و کنترل انتشار امواج نوری از طریق ایجاد نقص‌های نقطه‌ای و خطی در تیغه‌های بلور فوتونی استفاده می‌شود [۱]. دیودهای تمام نوری یا ایزولاتورهای نوری یکی از قطعه‌های مهم در اغلب مدارها مجتمع نوری و اتصال‌ها اپتیکی اند. در واقع نقش آن‌ها در مدارهای مجتمع نوری دوگان نقش دیودهای الکترونیکی در مدارهای الکترونیکی است اخیراً طراحی‌های مختلفی برای دیودهای تمام نوری ارائه شده است. بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی شامل میکروکاواک‌ها با ساختار غیرمتقارن [۲، ۳]، ساختارهایی برای بهره بردن از برهمکنش صوت و نور، بلورهای فوتونی مغناطیسی با تقارن پایین [۴]، استفاده از ماده‌های جاذب نامتقارن و غیرخطی به عنوان لایه جاذب [۵]، استفاده از پلاسمون‌های سطحی تنظیم پذیر و ساختارهای متقارن و غیرخطی PT [۶، ۷] از جمله این طرح‌ها هستند. هر یک از این ساختارها مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته اکثر این ساختارها با یک چالش مهم روبرو هستند و آن عدم پایداری در ابعاد خیلی کوچک است. از طرف دیگر در بعضی از ساختارهای دیگر مشخصات سیگنال ورودی و خروجی یکسان نیست. به عنوان مثال مشخصه فرکانس در حین عبور از ساختار دست خوش تغییر می‌شود. همچنین مسئله جذب (تلفات) و بازتابش مستقیم در بعضی از این ساختارها دارای اثر بسیار مخرب روی عملکرد ساختار است. به طوری که موجب شده است تا شدت سیگنال خروجی به شدت ضعیف شود و بی فایده باشد. در این مقاله قصد داریم دیودهای تمام نوری برپایه بلور فوتونی را مطالعه کنیم. عبوردهی نامتقارن درون ساختار فقط با تغییر سیگنال ورودی بدون هیچ دخالت دیگری بدست می‌آید. برای شبیه سازی ساختار مورد نظر از الگوریتم غیرخطی تفاضل متناهی در حوزه زمان استفاده می‌کنیم. در این طراحی پارامترهای مهم عملکرد دیودهای نوری نظیر عبوردهی بیشینه و کمینه، اختلاف عبوردهی مستقیم و برگشت و آستانه توان بهینه می‌شود.



شکل ۱ (الف): شمای ساده از یک ایزولاتور نوری شامل یک موجبر و دو کاواک، (ب) نمای از بالای ایزولاتور تعبیه شده بر بستر بلور فوتونی.

ضریب عبور و  $\gamma_B$  ضریب بازتاب میدان از حفره سد کننده،

$$\gamma_t = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_v \quad (3)$$

$$\gamma_v = \omega_0 / 2Q_v \quad (4)$$

$$\gamma_t = \omega_0 / 2Q_t \quad (5)$$

$\gamma_1$  و  $\gamma_2$  ضریب تلفات مربوط به کوپلینگ موجبر و کاواک در دو مسیر رفت و برگشت،  $\gamma_v$  نرخ واپاشی ذاتی کاواک و  $\gamma_t$  نرخ واپاشی کل کاواک است.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد اساس کارکرد این ساختار بر مبنای خاصیت غیر خطی سیلیکان با ضریب کر به عنوان بستر بلور فوتونی است. رابطه قطبیدگی در مواد را در حالت کلی میتوان به صورت زیر نوشت:

$$P = \epsilon_0 (\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \dots) \quad (6)$$

ضریب شکست وابسته به شدت نور را با استفاده از رابطه ی (۶) می توان به صورت ذیل نوشت:

$$n = n_0 + n_2 I \quad (7)$$

که در آن  $n_0$  ضریب شکست خطی ماده و

$$n_2 = \frac{3}{4\epsilon_r \epsilon_0 c} \chi^{(3)} \quad (8)$$

ضریب غیر خطی کر (برای  $Si$   $n_2 = 3.8 \times 10^{-16} m^2 w^{-1}$ ) و شدت نور برابر است با:

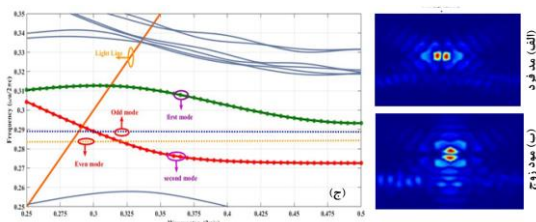
$$I = 2\epsilon_r \epsilon_0 c |E(\omega)|^2 \quad (9)$$

که در آن  $\epsilon_0$  و  $c$  به ترتیب ثابت دی الکتریک و سرعت نور در فضای آزاد است.

#### ۴- نتایج شبیه سازی

همانطور که در شکل ۲(الف) و (ب) مشاهده می کنید کاواک طراحی شده در ساختار دارای دو مد زوج و فرد در فرکانس های متفاوت بوده که ما از مد فرد کاواک به علت داشتن ضریب کیفیت بزرگتر ( $Q = \omega_0 / \Delta\omega = 21920$ ) و همچنین طول موج کاری (طول موج رزونانس کاواک نزدیک به  $1/55$  میکرومتر است) استفاده می کنیم.

ضریب غیرخطی سیلیکان  $n_2 = 3.8 \times 10^{-16} m^2 w^{-1}$  است با بهره زدن تقارن فضایی ساختار (حفره سد کننده در مرکز خط



شکل ۲ (الف) مد فرد و (ب) مد زوج کاواک، (ج) ساختار نوار موجبر بلور فوتونی. خط سبز و قرمز نمایانگر مد های اول و دوم موجبر درون گاف فوتونی ساختار شکل ۱(ب) اند. خط زرد رنگ خط نوری ساختار را نشان می دهد که تعیین کننده ی طول موج حد پایین برای عدد موج است. خطوط نقطه چین آبی و زرد به ترتیب مدهای فرد و زوج کاواک را نشان می دهد.

مسیر پیوسته برای تولید رزونانس فانو از یک حفره در مسیر موجبر استفاده شده است که با تغییر شعاع این حفره که المان عبوردهنده جزئی نیز نامیده می شود می توان طیف موج فانو را برای بدست آوردن مشخصات مطلوب تغییر داد. چون که اساس کار ساختار در اینجا اندرکنش غیرخطی موج درون کاواک است و هرچقدر این اندرکنش در حالت بایاس رفت و برگشت با هم تفاوت بیشتری داشته باشد عملکرد افزاره نوری برای عبور نامتقارن نور در دو جهت رفت و برگشت بهینه تر است چون که مقدار شیفیت طیف رزونانسی در دو حالت رفت و برگشت با هم اختلاف بیشتری پیدا می کند برای این منظور هر چقدر شعاع حفره سد کننده ( $R_B$ ) افزایش یابد اختلاف بین دو نرخ واپاشی  $\gamma_1$  و  $\gamma_2$  بیشتر خواهد شد ولی در ضمن افزایش شعاع این حفره باعث کاهش میزان عبوردهی ساختار می شود. ثابت شده است که بهترین حالت طیف رزونانسی برای عملکرد ایزولاتوری در این ساختار حالتی است که شعاع سد حفره ای  $150 nm$  باشد و سد حفره ای به اندازه یک یا دو ثابت شبکه از وسط ساختار به کناره ها شیفیت پیدا کند.

#### ۳- مدل سازی ضریب عبور

عبوردهی از ساختار ایزولاتور مورد نظر از رابطه زیر به دست می آید [۸، ۹]:

$$t(\omega) = \frac{t_B (\omega_0 - \omega) \pm \sqrt{4\gamma_1 \gamma_2 - t_B^2 (\gamma_1 + \gamma_2)^2} - j t_B \gamma_v}{j(\omega_0 - \omega) + \gamma_t} \quad (1)$$

که در آن

$$t_B = \sqrt{1 - r_B^2} \quad (2)$$

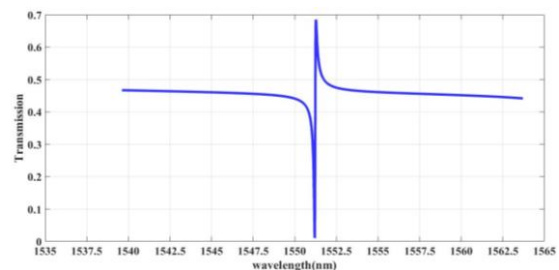
## ۵- نتیجه گیری:

در این مقاله یک افزاره عبوردهنده نامتقارن نور مبتنی بر ساختار غیرخطی و نامتقارن بلور فوتونی معرفی و نتایج شبیه سازی آن بررسی شد. مهمترین مزایای این ساختار عبارتند از: قابل مجتمع بودن به دلیل کوچکی مساحت ساختار، سادگی ساخت، پایین بودن هزینه ساخت، غیر فعال بودن افزاره و همچنین رسیدن به اختلاف نرخ گذردهی بسیار مطلوب ۴۶ db. در مقایسه با کارهای قبلی انجام شده در این زمینه می توان گفت که ساختار ارائه شده در این مقاله از حیث داشتن اختلاف نرخ گذردهی بسیار مطلوب و همچنین تنظیم پذیری در باند C مخابرات نوری برتری دارد.

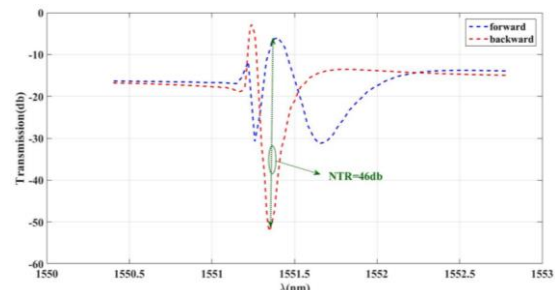
## مراجع:

- [1] Baba, T., *Remember the light*. Nature Photonics, 2007. **1**: p. 11-12.
- [2] Zhao, N.-S., et al., *Design of highly efficient optical diodes based on the dynamics of nonlinear photonic crystal molecules*. JOSA B, 2006. **23**(11): p. 2434-2440.
- [3].Nazari, F. and F. Samsami-Khodadad, *On chip optical isolator based on non-linear silicon photonic crystal by using asymmetric engineering waveguide*. Journal of Modern Optics, 2016: p. 1-6.
- [4].Khanikaev, A.B. and M. Steel, *Low-symmetry magnetic photonic crystals for nonreciprocal and unidirectional devices*. Optics express, 2009. **17**(7): p. 5265-5272.
- [5].Philip, R., et al., *Passive all-optical diode using asymmetric nonlinear absorption*. Applied Physics Letters, 2007. **91**(14): p. 141118.
- [6].Nazari, F., et al., *Optical isolation via* Optics express, 2014. **22**(8): p. 9574-9584.
- [7].Nazari, F., et al., *Asymmetric evolution of interacting solitons in parity time symmetric cells*. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2013. **49**(11): p. 932-938.
- [8].Fan, S., W. Suh, and J. Joannopoulos, *Temporal coupled-mode theory for the Fano resonance in optical resonators*. JOSA A, 2003. **20**(3): p. 569-572.
- [9].Heuck, M., et al., *Improved switching using Fano resonances in photonic crystal structures*. Optics letters, 2013. **38**(14): p. 2466-2468.

تقارن کاواک نیست) که نتیجه آن کوپلینگ متفاوت موجبر و کاواک بلور تقارن فوتونی از هر دو جهت رفت و برگشت می باشد. وقتی که ضریب کوپلینگ موجبر و کاواک در دو طرف متفاوت باشد باعث می شود که توان متفاوتی در هر دو جهت در کاواک بلور فوتونی هنگام بایاس رفت و برگشت محبوس شود بنابراین اثر غیرخطی که متناسب با توان یا دامنه ی میدان الکتریکی است در جهت رفت و برگشت متفاوت بوده و مقدار شیفیت طول موج رزونانسی با هم متفاوت است. مطلوب ما این است که این تفاوت به اندازه ای باشد که طول موجی که پیک منحنی عبوردهی مستقیم را دارد در منحنی عبوردهی برگشت دره ی منحنی باشد. در دامنه های کم میدان اعمالی، عبوردهی رفت و برگشت با هم یکسان است چون که ضریب شکست اطراف کاواک به علت پدیده ی غیر خطی کر تغییرات چندانی ندارد ولی هنگامی که دامنه ی میدان الکتریکی اعمالی زیاد باشد تغییر ضریب شکست حول کاواک مقدار محسوسی بوده و منحنی های عبوردهی رفت و برگشت برای وقتی که ورودی ما یک موج پیوسته با دامنه میدان الکتریکی  $1.0^8 \times 10^8$  ولت بر متر باشد ۴۶db اختلاف دارد و منحنی های عبوردهی رفت و برگشت مطابق شکل ۳ است.



شکل ۳. طیف عبور رفت و برگشت برای ساختار شکل ۱ (ب)، هنگامی که دامنه ی نور ورودی کم باشد.



شکل ۴. طیف عبور رفت و برگشت برای ساختار شکل ۱ (ب) هنگامی که دامنه ی میدان الکتریکی ورودی  $1.0^8 \times 10^8$  است.